

Реєстраційна картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0114U001890

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 04-07-2014

II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

Напрямок фінансування: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами ()

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

У тому числі по роках:	
2014	100 тис. грн.
2015	90 тис. грн.
2016	100 тис. грн.
2017	0 тис. грн.
Загальний обсяг фінансування: 190.75 тис. грн.	

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442346674, 380442262347, 380442396594, 380442343243

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: пр. Науки, 41, м. Київ, Київська обл., 03028, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380445254020

V. Відомості про співвиконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Центр експериментальних ,науково-технічних аналітичних та впроваджувальних робіт "ЦЕНТАВР"

Код за ЄДРПОУ: 19018149

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 442-95-18

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розроблення і створення технологій вирощування нанокристалічних багатокомпонентних структур енергонезалежної пам'яті для інформаційних систем

Назва роботи англійською:

Development and creation of technologies of growth of nanocrystalline multicomponent structures of nonvolatile memory for information systems

Мета роботи українською:

Розроблення технології створення структур енергонезалежної пам'яті з підвищеною радіаційною стійкістю на основі плівок оксинітриду кремнію з вбудованими нанокристалами кремнію.

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Нові речовини і матеріали

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Технології

Галузь застосування: Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Литовченко Володимир Григорович, Лісовський Ігор Петрович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розроблення і створення технологій вирощування нанокристалічних багатокомпонентних структур енергонезалежної пам'яті для інформаційних систем.

Початок етапу: 01.2014

Закінчення етапу: 12.2015

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 621.315.562, 62.382.2017.7; 621.397.579.017

Коди тематичних рубрик: 45.09.35

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Беляев Олександр Євгенович

д. ф.-м. н., 01.04.10

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

Юрченко Т.А.

